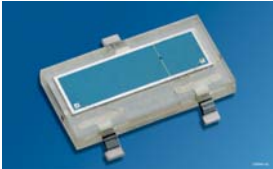


2-Chip Silicon PIN Photodiode
2-fach-Silizium-PIN-Fotodiode
Version 1.0

KOM 2125



Features:

- Especially suitable for applications from 400 nm to 1100 nm
- Short switching time (typ. 25 ns)
- Suitable for SMT

Applications

- Industrial electronics
- For control and drive circuits
- Edge control
- Path and angle scanning

Besondere Merkmale:

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 400 nm bis 1100 nm
- Kurze Schaltzeit (typ. 25 ns)
- SMT-fähig

Anwendungen

- Industrieelektronik
- Messen / Steuern / Regeln
- Kantenerkennung
- Weg- bzw. Winkelabtastungen

Ordering Information

Bestellinformation

Type: Typ:	Photocurrent Fotostrom $E_V = 1000 \text{ lx, Std. Light A, } V_R = 5 \text{ V;}$ Diode A $I_P [\mu\text{A}]$	Ordering Code Bestellnummer
KOM 2125	40 (≥ 30) (Diode A) 100 (≥ 75) (Diode B)	Q65110A2703

Maximum Ratings ($T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 80	$^{\circ}\text{C}$
Reverse voltage Sperrspannung	V_R	60	V
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	150	mW

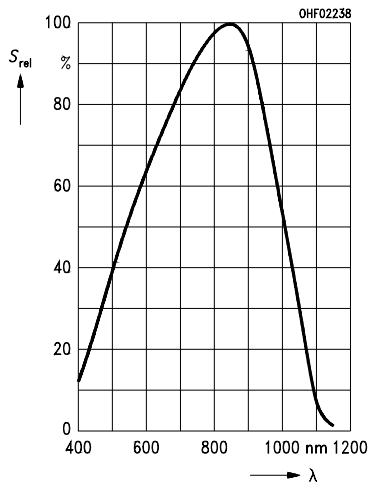
Characteristics ($T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Photocurrent Fotostrom ($E_v = 1000\text{ lx}$, Std. Light A, $V_R = 5\text{ V}$; Diode A)	I_P	40 (≥ 30)	μA
Photocurrent Fotostrom ($V_R = 5\text{ V}$, $\lambda = 870\text{ nm}$, $E_e = 1\text{ mW/cm}^2$, Diode B)	I_P	100 (≥ 75)	μA
Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{S\text{ max}}$	850	nm
Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{10\%}$	400 ... 1100	nm
Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche (Diode A)	A	4.00	mm^2
Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche (Diode B)	A	10.00	mm^2
Dimensions of radiant sensitive area Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche (Diode A)	L x W	2 x 2	mm x mm
Dimensions of radiant sensitive area Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche (Diode B)	L x W	2 x 5	mm x mm

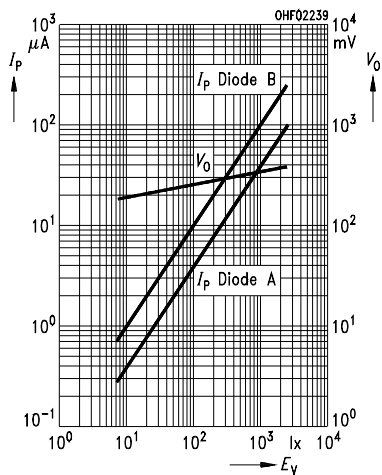
Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Half angle Halbwinkel	ϕ	± 60	$^{\circ}$
Dark current Dunkelstrom ($V_R = 10\text{ V}$; Diode A)	I_R	$5 (\leq 30)$	nA
Dark current Dunkelstrom ($V_R = 10\text{ V}$; Diode B)	I_R	$10 (\leq 30)$	nA
Spectral sensitivity of the chip Spektrale Fotoempfindlichkeit des Chips ($\lambda = 870\text{ nm}$)	$S_{\lambda \text{ typ}}$	0.62	A / W
Quantum yield of the chip Quantenausbeute des Chips ($\lambda = 870\text{ nm}$)	η	0.88	Electrons / Photon
Open-circuit voltage Leerlaufspannung ($E_v = 1000\text{ lx}$, Std. Light A)	V_O	$350 (\geq 300)$	mV
Short-circuit current Kurzschlussstrom ($E_v = 1000\text{ lx}$, Std. Light A; Diode A)	I_{SC}	38	μA
Short-circuit current Kurzschlussstrom ($E_v = 1000\text{ lx}$, Std. Light A; Diode B)	I_{SC}	95	μA
Rise and fall time Anstiegs- und Abfallzeit	t_r, t_f	0.018	μs
Rise and fall time Schaltzeit ($V_R = 5\text{ V}$, $R_L = 50\ \Omega$, $\lambda = 850\text{ nm}$; Diode B)	t_r, t_f	0.025	μs
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 100\text{ mA}$, $E = 0$)	V_F	1	V
Capacitance Kapazität ($V_R = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$; Diode A)	C_0	40	pF
Capacitance Kapazität ($V_R = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$; Diode B)	C_0	100	pF

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Temperature coefficient of V_O Temperaturkoeffizient von V_O	TC_V	-2.6	mV / K
Temperature coefficient of I_{SC} Temperaturkoeffizient von I_{SC} (Std. Light A)	TC_I	0.18	% / K
Noise equivalent power Rauschäquivalente Strahlungsleistung ($\lambda = 870$ nm, $V_R = 10$ V; Diode A)	NEP	0.065	pW / $\text{Hz}^{1/2}$
Noise equivalent power Rauschäquivalente Strahlungsleistung ($\lambda = 870$ nm, $V_R = 10$ V; Diode B)	NEP	0.091	pW / $\text{Hz}^{1/2}$
Detection limit Nachweisgrenze ($\lambda = 870$ nm, $V_R = 10$ V; Diode A)	D^*	3.1e12	cm x $\text{Hz}^{1/2}$ / W
Detection limit Nachweisgrenze ($\lambda = 870$ nm, $V_R = 10$ V; Diode B)	D^*	3.5e12	cm x $\text{Hz}^{1/2}$ / W

Relative Spectral Sensitivity
Relative spektrale Empfindlichkeit
 $S_{rel} = f(\lambda)$

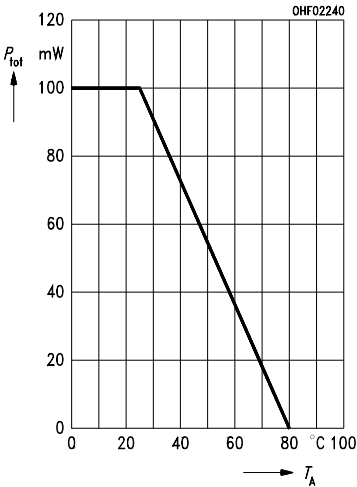


Photocurrent / Open-Circuit Voltage
Fotostrom / Leerlaufspannung
 $I_P (V_R = 5 \text{ V}) / V_O = f(E_V)$



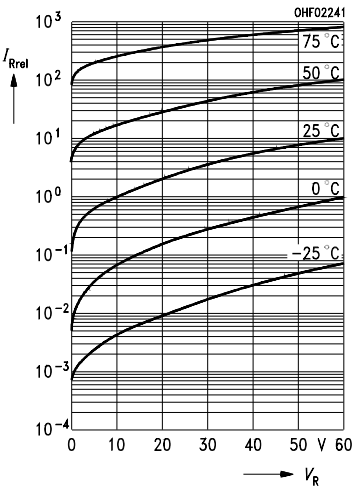
Total Power Dissipation
Verlustleistung

$P_{\text{tot}} = f(T_A)$



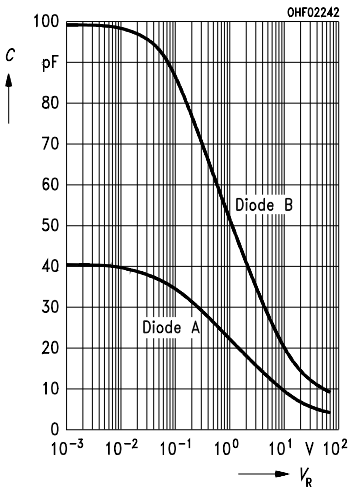
Dark Current
Dunkelstrom

$I_R = f(V_R), E = 0$, normalized to 10 V / 25 °C



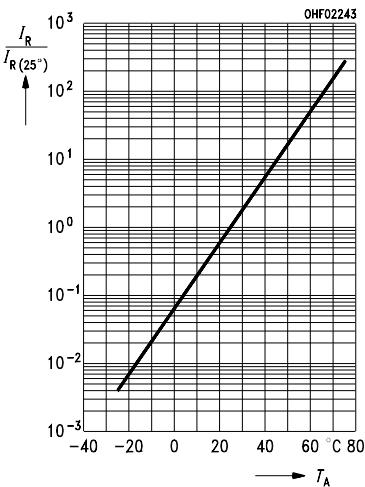
Capacitance
Kapazität

$C = f(V_R), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$



Dark Current
Dunkelstrom

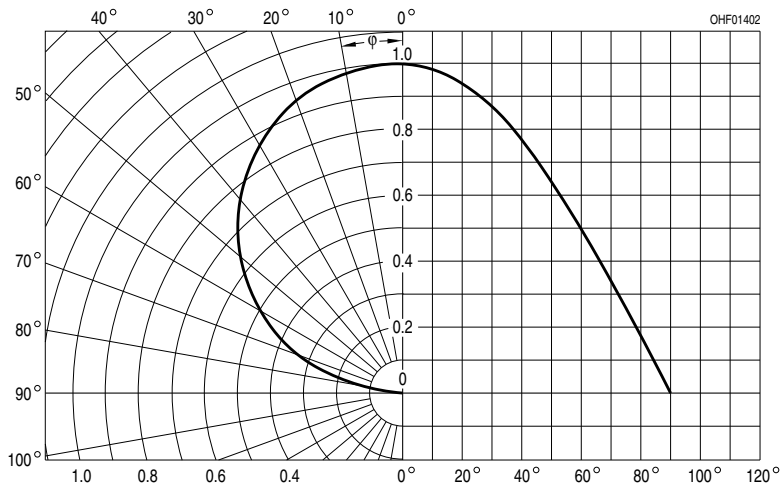
$I_R = f(T_A), V_R = 10 \text{ V}, E = 0$, normalized to $T_A = 25$ °C



Directional Characteristics

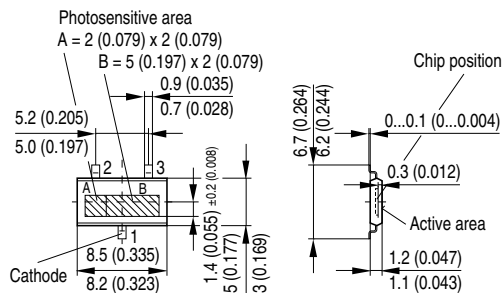
Winkeldiagramm

$$S_{\text{rel}} = f(\varphi)$$



Package Outline

Maßzeichnung



GEOY6860

Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Package

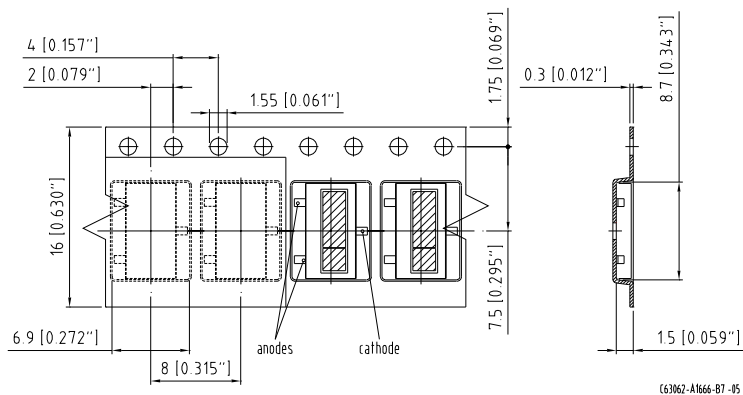
SMT DIL, Epoxy

Gehäuse

SMT DIL, Harz

Method of Taping

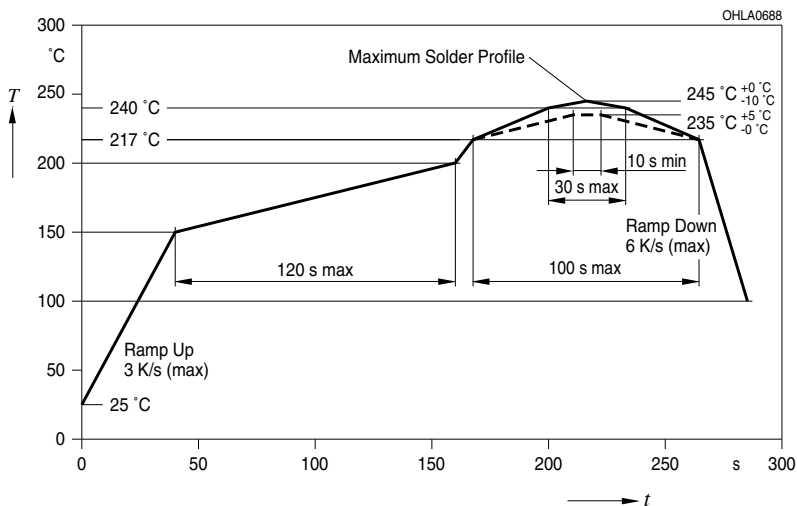
Gurtung



Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Reflow Soldering Profile**Reflow-Lötprofil**

Preconditioning: JEDEC Level 4 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；
国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。